

# 定制化Ptfе晶圆花篮耐化学腐蚀半导体清洗提手设计

货号: PL-CP166



## 简介

采用定制化PTFE晶圆载具和花篮，最大化半导体良率。专为卓越抵抗氢氟酸和苛刻试剂而设计，这些高纯度处理系统具有符合人体工程学的提手和精密CNC加工槽位，确保安全、无污染的湿法工艺清洗。

## 了解更多

应用	描述	主要优势
RCA清洗工艺	使用SC-1和SC-2溶液进行顺序清洗，以去除有机残留物和金属污染物。	抵抗高pH值和氧化应力，且不会将杂质浸出到清洗液中。
氢氟酸蚀刻	使用浓HF去除硅晶圆上的原生氧化层或牺牲玻璃层。	完全耐受HF，而HF通常会溶解玻璃或降解标准塑料。
食人鱼蚀刻/剥离	使用硫酸和过氧化氢的混合物去除重有机污染物或光刻胶。	在食人鱼溶液产生的高放热温度下保持结构完整性。
光刻显影	在紫外曝光后将晶圆浸入显影液以定义电路图案。	精密槽位确保晶圆表面均匀暴露于显影液。
CMP后漂洗	化学机械抛光后进行高纯度漂洗，以去除浆料颗粒。	防粘表面防止浆料积聚，便于快速、彻底的净化。
化合物半导体制造	用于高频电子和LED制造的GaAs、InP或SiC晶圆的处理。	温和的处理特性防止更脆性的化合物材料断裂。
超声波/兆声波清洗	在高频声学清洗过程中支撑晶圆，以去除亚微米颗粒。	在声空化力下具有优异的减振和化学稳定性。
规格类别	PL-CP166参数详情	定制选项
主要材料	高纯度原生PTFE (聚四氟乙烯)	可选PFA以增强透明度/纯度
兼容晶圆尺寸	4英寸 (100毫米)、6英寸 (150毫米)、8英寸 (200毫米)	可提供定制直径和非标准形状
槽位配置	精密切割的V型或U型槽轮廓	定制槽间距、深度和角度间隔
容量	标准25片或50片配置	从单晶圆到大批量的定制批次尺寸
提手设计	集成式顶部安装或侧面安装提手	可拆卸式、加长式或兼容自动化的提手
耐化学腐蚀性	全谱耐受 (酸、碱、溶剂、氧化剂)	已验证耐受HF、H2SO4、HNO3、HCl、NH4OH等
工作温度	-200°C 至 +260°C	可根据特定的热循环曲线定制
制造方法	端到端定制CNC加工	精密公差控制，适用于自动化接口
清洁协议	洁净室清洗并真空密封	针对痕量分析的特殊预清洗